

## ANEXO

**Referencia proyecto:** SA136P23

**Título Proyecto:** MEJORA DE LA TECNOLOGÍA DE DIODOS DE BARRERA SCHOTTKY DE GAN PARA ELECTRÓNICA EFICIENTE DE ALTA POTENCIA.

**Fecha de Publicación convocatoria:** 13/12/2023

**Fin de Plazo de presentación de solicitudes:** 12/01/2024

**Entidad financiadora:** Junta de Castilla y León, cofinanciación con Fondos FEDER.

**Categoría:** Investigador/a Posdoctoral.

**Jornada semanal:** 37.5 horas

**Horario:** Lunes - Jueves: 9-14 y 16-18,30 Viernes: 8-15,30

**Modalidad de Contrato:** “contrato de acceso de personal investigador doctor establecido en el artículo 20.1.b) de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por tres años de duración.”

**Número de contratos:** 1

**Retribución anual:** 12 pagas de 2.330€ mensuales. Salario=1.997,14€ y parte proporcional de las pagas extras= 332,86€

**Lugar de trabajo:** Universidad de Salamanca

**Centro, departamento o Instituto:** Departamento de Física Aplicada

**Fecha prevista de inicio de contrato:** 01/03/2024

**Fecha prevista de fin de contrato:** 28/02/2027

**Comisión de Selección:**

Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue

Vocal 1: Tomás González Sánchez

Vocal 2: María Susana Pérez Santos

Secretario: Beatriz García Vasallo

**Clave Orgánica de gasto:** 18JGV 463AC03

### **Objeto del Contrato:**

Realización de tareas de investigación vinculadas al proyecto **SA136P23** según se describe a continuación.

### **Tareas a realizar:**

- Caracterización eléctrica (DC, RF) y en espacio libre de diodos de barrera Schottky y transistores para aplicaciones de sub-THz, incluyendo medidas en función de la temperatura (10-500K).
- Simulación de dispositivos semiconductores y circuitos electrónicos para el desarrollo de emisores y detectores de RF y sub-THz.
- Apoyo en la fabricación de dispositivos en sala blanca.

### **Requisitos específicos:**

1. **Titulación:** Doctorado en disciplinas afines al proyecto (Física, Ingeniería Electrónica o Ingenierías afines)

### **Documentación a presentar:**

- Fotocopia del DNI o documento equivalente en el caso de extranjeros.
- Copia del título de Doctor o de la certificación académica, donde figure indicación expresa de la fecha en la que se obtuvo el grado de Doctor.
- Currículum Vitae completo que recoja los apartados indicados en los Méritos Curriculares y Experiencia.
- Acreditación documental de los méritos reflejados en el CV
- Vida Laboral

### **Méritos y valoración de los mismos:**

Para poder optar a la plaza, es necesario que el candidato obtenga una puntuación igual o superior a 65 puntos

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente

1. **Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (70% - 70 puntos sobre 100)**

Se considerarán los siguientes méritos, valorándose su afinidad con los objetivos del proyecto y las tareas a realizar:

- Expediente académico de titulaciones de grado y máster (o equivalentes) (10 puntos)
- Publicaciones científicas y patentes (30 puntos)
- Contribuciones en congresos (10 puntos)
- Participación en proyectos de investigación (5 puntos)

- Estancias en centros internacionales (10 puntos)
- Otros méritos (5 puntos)

2. Experiencia en Técnicas, Experiencias Laborales y Conocimientos relacionados con el Perfil de la Plaza (30% / 30 puntos sobre 100)

- Caracterización eléctrica y en espacio libre de dispositivos semiconductores de RF y sub-THz (experiencia en el manejo de analizadores vectoriales de redes, analizadores de espectros, osciloscopios digitales de altas prestaciones, estaciones de puntas criogénicas, etc.). (10 puntos)
- Desarrollo de protocolos automatizados de medida. (5 puntos)
- Experiencia en tecnologías de GaN. (5 puntos)
- Simulación de dispositivos semiconductores y circuitos de RF y sub-THz. (5 puntos)
- Técnicas de fabricación de dispositivos en sala blanca (fotolitografía, litografía por haz de electrones, grabado, etc.). (5 puntos)